

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

high-resistance unit (20H) and a higher resistivity than the low-resistance unit (20L); and a medium-high-resistance unit (20MH) having a high-resistance unit (20H) connected to the high-resistance unit (20H) of the low/high-resistance unit (20LH) on both side surfaces in one direction of the medium-resistance unit (20M).

(57) 要約: 一端にコンタクト部 (20C) を有し、他端に回路基板に接触される端子部 (20T) を有するプローブ (20) であって、プローブ (20) は、第1金属からなる低抵抗部 (20L) を、低抵抗部 (20L) の抵抗率よりも高い抵抗率の第2金属からなる高抵抗部 (20H) によって覆った低-高抵抗部 (20LH) と、低抵抗部 (20L) にプローブ (20) の長手方向 (X) に接続され、高抵抗部 (20H) の抵抗率よりも低くかつ、低抵抗部 (20L) の抵抗率よりも抵抗率が高い第3金属からなる中抵抗部 (20M) と、中抵抗部 (20M) の一方向の両側面に低-高抵抗部 (20LH) の高抵抗部 (20H) と繋がった高抵抗部 (20H) を有する中-高抵抗部 (20MH) とを備える。